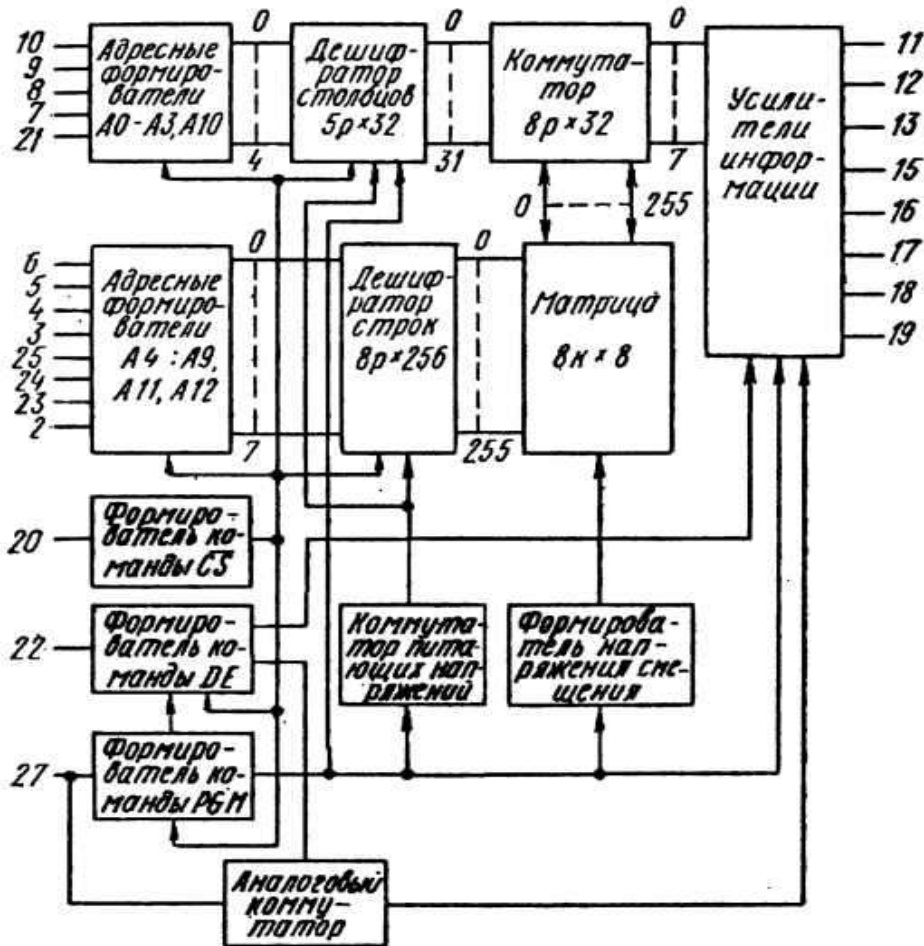
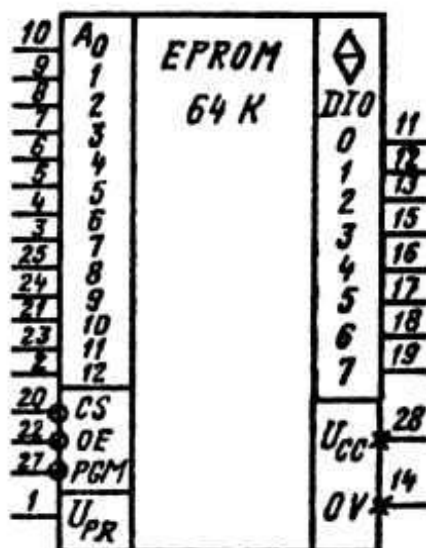


К573РФ6А, К573РФ6Б

Микросхемы представляют собой электрическое программируемое ПЗУ емкостью 64 кбит (8кx8) с ультрафиолетовым стиранием информации, обеспечивающее длительное хранение информации независимо от режимов работы и возможность изменения записанной информации в процессе селективного программирования. Содержат 135210 интегральных элементов. Корпус типа 2121.28-6, масса не более 5,7 г.



Структурная схема К573РФ6



Условное графическое обозначение К573РФ6

Назначение выводов: 1 - напряжение программирования U_{PR} ; 2 - адрес A12; 3 - адрес A7; 4 - адрес A6; 5 - адрес A5; 6 - адрес A4; 7 - адрес A3; 8 - адрес A2; 9 - адрес A1; 10 - адрес A0; 11 - выход DIO0; 12 - выход DIO1; 13 - выход DIO2; 14 - общий; 15 - выход DIO3; 16 - выход DIO4; 17 - выход DIO5; 18 - DIO6; 19 - выход DIO7; 20 - вход \overline{CS} ; 21 - адрес A10; 22 - включение выхода \overline{OE} ; 23 - адрес A11; 24 - адрес A9; 25 - адрес A8; 26 - свободный; 27 - программирование \overline{PGM} ; 28 - напряжение питания.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение питания 5 В \pm 5%
- Выходное напряжение высокого уровня
(при $U_n = 4,75$ В, $U_{пр} = 4,75$ В, $U_{вх}^1 = 2,2$ В, $U_{вх}^0 = 0,6$ В):
- в режиме "считывание" $\geq 2,4$ В
 - при программировании ≥ 2 В
- Выходное напряжение низкого уровня:
- в режиме "считывание" $\leq 0,4$ В
 - при программировании ≤ 1 В
- Ток потребления (при $U_n = 5,25$ В):
- в режиме "считывания" ≤ 100 мА
 - при программировании ≤ 150 мА
- Ток потребления в режиме хранения по выводу 1:
- в режиме "считывания" ≤ 4 мА
 - при программировании ≤ 30 мА
 - в режиме "невыбор ИС" ≤ 15 мА
- Ток потребления в режиме "невыбор ИС" ≤ 40 мА

- Выходной ток низкого уровня $\leq 1,6$ мА
 Выходной ток высокого уровня $\leq |-100|$ мкА
 Ток утечки на входах в режиме "считывание" ≤ 10 мкА
 Ток утечки на входах в режиме "невыбор ИС" ≤ 30 мкА
 Ток утечки на выходах в режиме работы "невыбор ИС" ≤ 30 мкА
 Потребляемая мощность:
 - в режиме обращения ≤ 870 мВт
 - в режиме хранения ≤ 265 мВт
 Время установления высокого импеданса на выходе ≤ 150 нс
 Время нарастания фронта (спада) ≤ 100 нс
 Время выборки адреса в режиме "считывание"
 (при $U_n = 4,75$ В, $U_{пр} = 4,75$ В, $U^1_{вх} = 2,4$ В, $U^0_{вх} = 0,4$ В):
 - К573РФ6А ≤ 280 нс
 - К573РФ6Б ≤ 400 нс
 Время выборки по выводу 20:
 - К573РФ6А ≤ 300 нс
 - К573РФ6Б ≤ 450 нс
 Время выборки по выводу 22 ≤ 150 нс
 Время хранения информации выключенном состоянии ≥ 5 лет
 Время хранения информации во включенном состоянии $2 \cdot 10^4$ ч
 Количество циклов перепрограммирования ≥ 25

Режим работы ИС

Режим работы	\overline{CS}	\overline{OE}	\overline{PGM}	U_p	U_n	Входы - выходы
"Считывание"	$U^0_{вх}$	$U^0_{вх}$	$U^1_{вх}$	U_p	U_n	Выходная информация
"Невыбор ИС"	$U^1_{вх}$	-	-	U_p	U_n	Высокий импеданс
"Программирование"	$U^0_{вх}$	$U^1_{вх}$	Импульс \overline{PGM}	U_p	U_n	Входная информация
"Запрет программирования"	$U^1_{вх}$	-	-	U_p	U_n	Высокий импеданс
"Проверка программирования"	$U^0_{вх}$	$U^0_{вх}$	$U^1_{вх}$	U_p	U_n	Выходная информация

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Максимальное напряжение питания	5,25 В
Минимальное входное напряжение высокого уровня	2,4 В
Максимальное напряжение на выводе 1	5,25 В
Выходной ток высокого уровня	-180...0 мкА
Выходной ток низкого уровня	0...1,8 мА
Максимальная емкость нагрузки	100 пФ
Температура окружающей среды	-10...+70 °С